

**特点:**

- 频率: 2~12GHz
- 插入损耗: 0.6dB@12GHz
- 均衡量: 8dB
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 0.85×1.0×0.1mm

**性能参数: (T<sub>A</sub>=+25℃)**

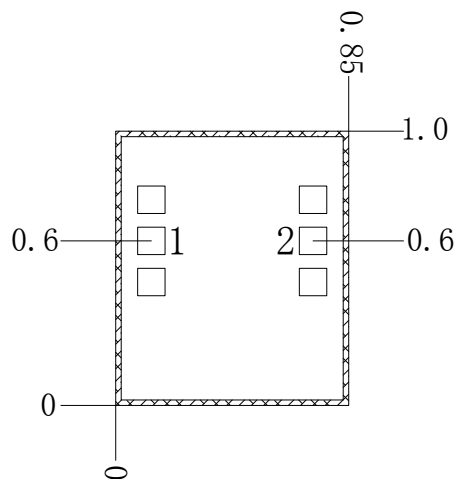
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	Z <sub>in</sub> =Z <sub>out</sub> =50Ω	2		12	GHz	
插入损耗	IL			0.6		dB	@12GHz
均衡量				8		dB	
输入驻波	VSWR <sub>i</sub>			1.2	1.5		
输出驻波	VSWR <sub>o</sub>			1.2	1.5		

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入功率	+30	dBm	贮存温度	-55~+150	℃

**芯片尺寸图:**

单位: mm

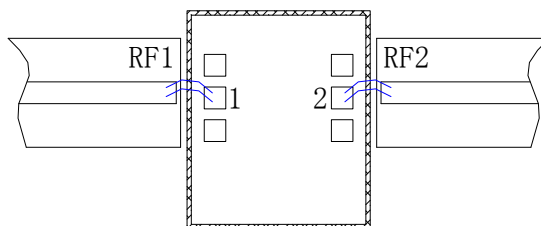


注: 典型键合焊盘尺寸为 100\*100um

**引脚定义:**

引脚	定义	描述
1	RF1	射频支路端口 1, 50Ω
2	RF2	射频支路端口 2, 50Ω
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

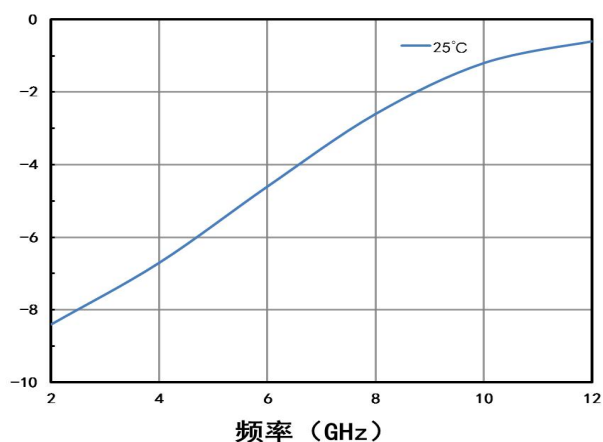
**推荐装配图：**



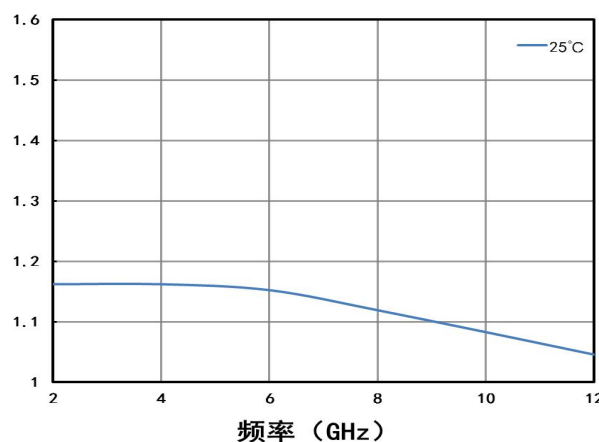
注：未标注的键合焊盘不需要连接

**典型测试曲线：**

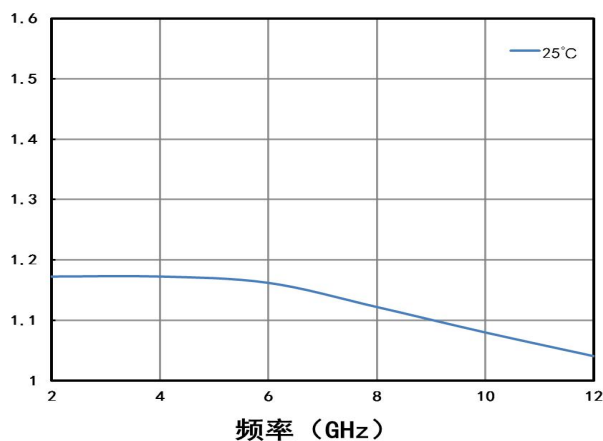
插入损耗 (dB)



输入驻波比



输出驻波比



**产品使用注意事项：**

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。